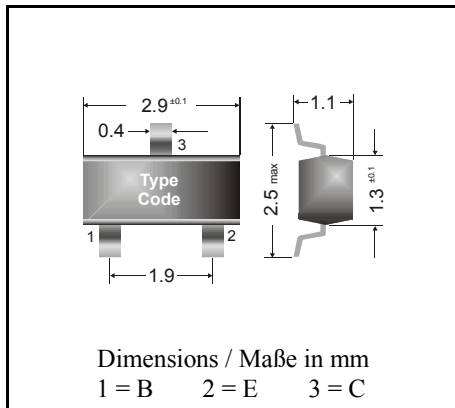


PNP

**Surface mount Si-Epitaxial Planar Transistors**  
**Si-Epitaxial Planar Transistoren für die Oberflächenmontage**

PNP



Power dissipation – Verlustleistung 250 mW

Plastic case SOT-23  
Kunststoffgehäuse (TO-236)

Weight approx. – Gewicht ca. 0.01 g

Plastic material has UL classification 94V-0  
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziertStandard packaging taped and reeled  
Standard Lieferform gegurtet auf Rolle**Maximum ratings ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )****Grenzwerte ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )**

			<b>BCW 29, BCW 30</b>
Collector-Emitter-voltage	B open	$-V_{CE0}$	32 V
Collector-Base-voltage	E open	$-V_{CB0}$	32 V
Emitter-Base-voltage	C open	$-V_{EB0}$	5 V
Power dissipation – Verlustleistung		$P_{tot}$	250 mW <sup>1)</sup>
Collector current – Kollektorstrom (DC)		$-I_C$	100 mA
Peak Collector current – Kollektor-Spitzenstrom		$-I_{CM}$	200 mA
Peak Base current – Basis-Spitzenstrom		$-I_{BM}$	200 mA
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		$T_j$	150 °C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		$T_S$	- 65...+ 150 °C

**Characteristics ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ )****Kennwerte ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ )**

		<b>Min.</b>	<b>Typ.</b>	<b>Max.</b>
Collector-Base cutoff current – Kollektorreststrom				
$I_E = 0, -V_{CB} = 32\text{ V}$	$-I_{CB0}$	–	–	100 nA
$I_E = 0, -V_{CB} = 32\text{ V}, T_j = 100^\circ\text{C}$	$-I_{CB0}$	–	–	10 $\mu\text{A}$
Emitter-Base cutoff current – Emitterreststrom				
$I_C = 0, -V_{EB} = 5\text{ V}$	$-I_{EB0}$	–	–	100 nA
Collector saturation volt. – Kollektor-Sättigungsspg. <sup>2)</sup>				
$-I_C = 10\text{ mA}, -I_B = 0.5\text{ mA}$	$-V_{CEsat}$	–	80 mV	300 mV
$-I_C = 50\text{ mA}, -I_B = 2.5\text{ mA}$	$-V_{CEsat}$	–	150 mV	–

<sup>1)</sup> Mounted on P.C. board with 3 mm<sup>2</sup> copper pad at each terminal  
 Montage auf Leiterplatte mit 3 mm<sup>2</sup> Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluß

<sup>2)</sup> Tested with pulses  $t_p = 300\ \mu\text{s}$ , duty cycle  $\leq 2\%$  – Gemessen mit Impulsen  $t_p = 300\ \mu\text{s}$ , Schaltverhältnis  $\leq 2\%$

Characteristics ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ )Kennwerte ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ )

		Min.	Typ.	Max.
Base saturation voltage – Basis-Sättigungsspannung <sup>1)</sup>				
- $I_C = 10\text{ mA}$ , - $I_B = 0.5\text{ mA}$	- $V_{BEsat}$	–	720 mV	–
- $I_C = 50\text{ mA}$ , - $I_B = 2.5\text{ mA}$	- $V_{BEsat}$	–	810 mV	–
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis <sup>1)</sup>				
- $V_{CE} = 5\text{ V}$ , - $I_C = 10\text{ }\mu\text{A}$	BCW 29	$h_{FE}$	–	90
	BCW 30	$h_{FE}$	–	150
- $V_{CE} = 5\text{ V}$ , - $I_C = 2\text{ mA}$	BCW 29	$h_{FE}$	120	–
	BCW 30	$h_{FE}$	215	–
Base-Emitter voltage – Basis-Emitter-Spannung <sup>1)</sup>				
- $V_{CE} = 5\text{ V}$ , - $I_C = 2\text{ mA}$	- $V_{BEon}$	600 mV	–	750 mV
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz				
- $V_{CE} = 5\text{ V}$ , - $I_C = 10\text{ mA}$ , $f = 100\text{ MHz}$	$f_T$	100 MHz	–	–
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität				
- $V_{CB} = 10\text{ V}$ , $I_E = i_e = 0$ , $f = 1\text{ MHz}$	$C_{CB0}$	–	4.5 pF	–
Noise figure – Rauschzahl				
- $V_{CE} = 5\text{ V}$ , - $I_C = 200\text{ }\mu\text{A}$ , $R_G = 2\text{ k}\Omega$ , $f = 1\text{ kHz}$ , $\Delta f = 200\text{ Hz}$	F	–	–	10 dB
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft		$R_{thA}$	420 K/W <sup>2)</sup>	
Recommended complementary NPN transistors Empfohlene komplementäre NPN-Transistoren		BCW 31, BCW 32		
Marking – Stempelung		BCW 29 = C1	BCW 30 = C2	

<sup>1)</sup> Tested with pulses  $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$ , duty cycle  $\leq 2\%$  – Gemessen mit Impulsen  $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$ , Schaltverhältnis  $\leq 2\%$

<sup>2)</sup> Mounted on P.C. board with  $3\text{ mm}^2$  copper pad at each terminal  
Montage auf Leiterplatte mit  $3\text{ mm}^2$  Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluß